

最大额定值/MAXIMUM RATINGS

参数 Parameter	符号 Symbol	额定值 Rating	单位 Unit
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-32	V
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-40	V
发射极-基极电压 Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
集电极直流电流 Collector Current	I_C	-1.5	A
总耗散功率($T_A=25^\circ\text{C}$)* Total Device Dissipation($T_A=25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	1.2	W
最高工作结温 Junction Temperature(Max)	T_{JM}	150	$^\circ\text{C}$
贮存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

* 器件安装在印制电路板上
Device mounted on a printed circuit board.

PNP-硅通用晶体管
1.2W、1.5A、32V



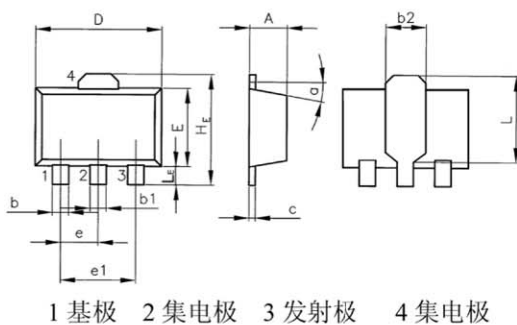
DEVICE MARKING

2SB1188 =BCR*

电性能/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A=25^\circ\text{C}$)

参数名称 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test condition	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
击穿电压 Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}, I_B=0$	-32	—	—	V
	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=50\mu\text{A}, I_E=0$	-40	—	—	V
	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=50\mu\text{A}, I_C=0$	-5	—	—	V
集电极截止电流 Collector-Cutoff Current	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$	—	—	-500	nA
直流放大系数 DC Current Gain	h_{FE}	$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=3.0\text{V}$	190	—	300	—
集电极-发射极饱和电压 Collector- Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	—	—	-0.50	V
特征频率 Current Gain-Bandwidth Product	f_T	$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$	150	—	—	MHz

SOT-89 外形尺寸



单位: mm

尺寸 符号	SOT-89			尺寸 符号	SOT-89		
	min	typ	max		min	typ	max
A		1.5		e		1.5	
b			0.65	e1		3	
b1			0.65	H_E			4.25
b2		1.6		L	2.6		2.95
c	0.25			L_E	0.8		1.2
D		4.5		α			10°
E			2.6				

SK MAKE CONSCIOUS PRODUCT

CONSCIOUS PRODUCTS BEGIN WITH CONSCIOUS PEOPLE

